

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 02-142045  
 (43) Date of publication of application : 31.05.1990

(51) Int.CI. H01J 37/147  
 H01J 37/05

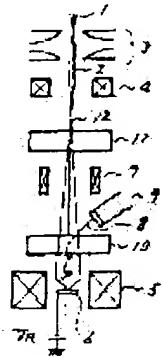
(21) Application number : 63-294527 (71) Applicant : HITACHI LTD  
 (22) Date of filing : 24.11.1988 (72) Inventor : KURODA KATSUHIRO

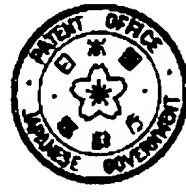
**(54) SCAN TYPE ELECTRON MICROSCOPE AND SIMILAR DEVICE THEREOF**

**(57) Abstract:**

**PURPOSE:** To achieve a high resolution in a low acceleration range, and obtain a high detection sensitivity for secondary electrons by using a filter of an in-lens type where a sample is disposed inside a lens, and of an  $E \times B$  type which decelerates a primary electron beam by applying a negative voltage to the sample while crossing an electric field with a magnetic field.

**CONSTITUTION:** An electron beam 2 generated from an electron gun 1 is throttled through an acceleration lens 3, a capacitor lens 4, and an objective lens 5, for example, to be thin and radiated on a sample 6. The electron beam 2 is scanned on the sample 6 two-dimensionally by a deflector 7, and a secondary electron 8 generated from the sample 6 is detected by a secondary electron detector 9 to be an image signal. A negative voltage  $VR$  is then applied to the sample 6 for decelerating the electron beam 2, and the generated secondary electron 8 is accelerated by the decelerating voltage  $VR$  inversely, so it cannot be deflected to the detector 9 sufficiently only by the electric field of the detector 9. A filter 10 of a so-called  $E \times B$  type where an electric field is made to cross with a magnetic field is disposed between the objective lens 5 and the detector 9 to eliminate the effects on the route of the electron beam 2. A high resolution and a high detection sensitivity for secondary charged particles can thus be obtained in a low acceleration range.





(19)

(11) Publication number:

**02142045 A**

Generated Document

**PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**(21) Application number: **63294527**(51) Int'l. Cl.: **H01J 37/147 H01J 37/05**(22) Application date: **24.11.88**

(30) Priority:

(43) Date of application  
publication: **31.05.90**(84) Designated contracting  
states:(71) Applicant: **HITACHI LTD**(72) Inventor: **KURODA KATSUHIRO**

(74) Representative:

**(54) SCAN TYPE ELECTRON  
MICROSCOPE AND  
SIMILAR DEVICE  
THEREOF**

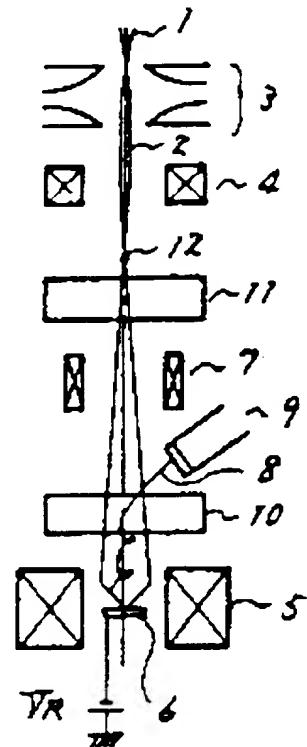
(57) Abstract:

**PURPOSE:** To achieve a high resolution in a low acceleration range, and obtain a high detection sensitivity for secondary electrons by using a filter of an in-lens type where a sample is disposed inside a lens, and of an  $E \times B$  type which decelerates a primary electron beam by applying a negative voltage to the sample while crossing an electric field with a magnetic field.

**CONSTITUTION:** An electron beam 2 generated from an electron gun 1 is throttled through an acceleration lens 3, a capacitor lens 4, and an objective lens 5, for example, to be thin and radiated on a sample 6. The electron beam 2 is scanned on the sample 6 two-dimensionally by a deflector 7, and a secondary electron 8 generated from the sample 6 is detected by a secondary electron detector 9 to be an image signal. A negative voltage VR is then applied to the sample 6 for

decelerating the electron beam 2, and the generated secondary electron 8 is accelerated by the decelerating voltage  $V_R$  inversely, so it cannot be deflected to the detector 9 sufficiently only by the electric field of the detector 9. A filter 10 of a so-called  $E \times B$  type where an electric field is made to cross with a magnetic field is disposed between the objective lens 5 and the detector 9 to eliminate the effects on the route of the electron beam 2. A high resolution and a high detection sensitivity for secondary charged particles can thus be obtained in a low acceleration range.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A) 平2-142045

⑫ Int. Cl. 5

H 01 J 37/147  
37/05

識別記号

序内整理番号

B 7013-5C  
7013-5C

⑬ 公開 平成2年(1990)5月31日

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

⑭ 発明の名称 走査形電子顕微鏡及びその類似装置

⑮ 特願 昭63-294527

⑯ 出願 昭63(1988)11月24日

⑰ 発明者 黒田 勝広 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑱ 出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑲ 代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

## 明細書

## 1. 発明の名称

走査形電子顕微鏡及びその類似装置

## 2. 特許請求の範囲

1. 電子線と、該電子線からでた電子線を細く絞って試料に照射するレンズ手段、該電子線を該試料上で二次元的に走査する走査手段、該試料からでてくる二次電子を検出する検出手段とかなる装置において、該試料には負の電圧を印加し、かつ該試料と該検出手段との間ならびに該検出手段に対して該電子源側にそれぞれ電界 (E) と磁界 (B) を直行させたいわゆる  $E \times B$  形フィルタを配置したことを特徴とする走査形電子顕微鏡及びその類似装置。

2. 荷電粒子源と、該荷電粒子源からでた荷電粒子線を細く絞って試料に照射するレンズ手段、該荷電粒子線を該試料上で二次元的に走査する走査手段、該試料からでてくる二次荷電粒子を検出する検出手段とかなる装置において、該試料には上記荷電粒子が負の荷電粒子であると

き負の電圧を、上記荷電粒子が正の荷電粒子であるとき正の電圧を印加し、かつ該試料と該検出手段との間ならびに該検出手段に対して該荷電粒子源側にそれぞれ電界 (E) と磁界 (B) を直行させたいわゆる  $E \times B$  形フィルタを配置したことを特徴とする走査形荷電粒子顕微鏡及びその類似装置。

3. 試料配置部が、レンズの内部に配設されたことを特徴とする請求項第1項記載の走査形荷電粒子顕微鏡及びその類似装置。

4. 上記  $E \times B$  形フィルタの電界の方向を、検出手手段の方向と一致させたことを特徴とする請求項第1項もしくは第2項のいずれかに記載の走査形荷電粒子顕微鏡及びその類似装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## 【装置上の利用分野】

本発明は、走査形荷電粒子顕微鏡及びその類似装置に係り、特に低加速領域において高分解能でかつ二次電子の高検出効率に好適な荷電粒子光学系に関するものである。

### 〔従来の技術〕

走査形電子顕微鏡の分解能を向上させるために、特願昭60-136004に記載されているような光学系が用いられている。すなわち、譜度が高く、エネルギー幅の小さな電界放射形(FE)電子線と、レンズの内部に試料を配置して収差を極力小さくしたインレンズ形対物レンズとを組合わせたものである。このような光学系においても低加速電圧域においては分解能は低下する。

一方、色収差を低減するために、特公昭63-34588に記載されているような光学系が提案されている。

この光学系は、電子線が試料を照射する直前まで高加速電圧とし、試料照射時に減速して低加速電圧化するものである。この場合、レンズ通過時の電子線のエネルギーが高いので、レンズ収差を小さくできる。すなわち、高分解能化が図れる。

以上の観点から、低加速領域で従来以上の高分解能を得るために、上記両者の光学系を組合せれば可能となる。すなわち、試料はレンズの内部

に配置し、この試料に負の電圧を印加して減速すればよい。

ただ、この場合問題となるのは二次電子の検出である。試料がレンズの外部にある従来の場合には、特公昭63-34588に示されてているように、一次電子線の減速電界で二次電子が加速されると同時に二次電子検出器の電界で二次電子を検出するように構成すればよかつた。しかし、試料をレンズの内部に配置したインレンズ形では、レンズの磁界が強いためにこの磁界に二次電子が強く束縛されるばかりでなく、二次電子検出器をレンズの内部に配置できないという問題が生じる。

### 〔発明が解決しようとする課題〕

本発明の目的は、低加速領域で高分解能化を図り、かつ二次電子の面検出感度が得られる電子光学系を提供することにある。

### 〔課題を解決するための手段〕

低加速電圧で高分解能を得るために、試料をレンズの内部に配置したインレンズ形でかつこの試料に負の電圧を印加して一次電子線を減速させ

ればよいことはすでに述べた。この光学系で、二次電子の高検出効率化を図るために、一次電子線の減速電界で加速された二次電子をレンズ通過後検出器の方に偏向させればよい。ただこの場合、一次電子線には影響しないよう二次電子のみを検出器の方に偏向する必要がある。そのためには、電界 ( $E$ ) と磁界 ( $B$ ) とを直行させたいわゆる  $E \times B$  形のフィルタを用いれば可能となる。

### 「作用」

まず、試料照射の直前に電子線の減速を行えば、低加速電圧でも高分解能が得られることは従来技術からも分かる。

一方、二次電子検出に関しては、 $E \times B$  形のフィルタを試料と検出器との間に用いているので、一次電子線を直進するようにしてやれば、エネルギーの異なる二次電子は自然に偏向されることになる。すなわち、第5図に示すように電子線2の加速電圧  $V$  にたいして、次式を満足するように  $E$  と  $B$  を印加すれば、電子線2の軌道に影響を与えない。

ここで、 $k = \sqrt{e/2mV_0}$  ,  $e/m$  : 電子の電荷/質量である。

この時、検出すべき二次電子  $E$  のエネルギーは減速電圧  $V$  でありかつ電子線  $2$  と方向が逆であるので、二次電子  $E$  の偏角  $\theta$  は、

$$\tan \theta = E L \left( 1 + \sqrt{\frac{V_R}{V_0}} \right) / 2 V_R \quad \dots \dots \dots (2)$$

となる。  
この偏向方向を検出器の方向と一致させておけば、  
二次電子は検出器に向かって進むので、検出効率  
の向上が図れることになる。

〔文稿集〕

本発明の二審原判を第1図により説明する。

電子線 1 からでた電子線 2 は、幾つかのレンズ（本実施例では加速レンズ 3、コンデンサレンズ 4、対物レンズ 5）により細く絞られて試料 6 上を照射する。この電子線 2 は偏向器 7 により試料 6 上で二次元的に走査される。また、試料 6 からでてきた二次電子 8 は、二次電子検出器 9 により検出されて映像信号となる。

ここで、試料6は電子線2を減速するために負の電圧 $V_R$ が印加されている。このとき、出てきた二次電子はこの減速電圧 $V_R$ により逆に加速され、検出器9の電界のみでは十分に検出器9の方に偏向できなくなる。

そこで、出てきた二次電子8を検出器9の方に偏向するために偏向器を配置すればよいが、電子線2の軌道に影響のないように電界Eと磁界Bとを直行させたいわゆるE×B形のフィルタ10を対物レンズ5と検出器9との間に配置している。

このとき、(1)式のようにEとBを印加すれば、電子線2の軌道には影響を与えずに二次電子8のみを検出器の方に偏向でき、検出効率の向上が図られる。

ただこの場合、フィルタ10による色収差が問題になる。この色収差による偏向角 $\beta$ は、

$$\beta = \Delta V E L / 4 V_0^2$$

$$= \tan \theta \Delta V V_R / 2 V_0^2 (1 + \sqrt{V_R / V_0}) \quad \dots \dots \dots (3)$$

で表わされる。ここで、 $\Delta V$ は電子線2のエネルギー幅である。

く、二次電子8のみを検出器9の方に偏向することが可能となる。すなわち、低加速領域でも高分解能でかつ二次電子の高検出効率が得られることになる。

第1図に示す本発明を実施した結果のごく一例を以下に示す。フィルタ11を物点12とフィルタ10とのほぼ中間に配置して電界Eと磁界Bとの作用長を約20mmとなるように構成し、 $V = 1 kV$ と固定にして $V_R = 0 \sim 900 V$ と変化させた。このとき、フィルタ10、11のそれぞれのEとBの強さを $E = 0 \sim 25 V/mm$ 、 $0 \sim 50 V/mm$ 、 $B = 0 \sim 14$ ガウス(Gauss)、 $0 \sim 28$ Gaussと $V_R$ に連動させて変化させたところ、 $4 \sim 6$ nmの高分解能が実現できた。

本発明は、1kV以下の低加速電圧でnmオーダの分解能を得ることを目的になされたため、フィルタを2段にしたが、目的によっては1段で構成しても二次電子の高検出効率化は可能であることは、本実施例で述べた通りである。

また、本実施例では試料がレンズの内部に配置

すなわち、第2図に示すようにこの色収差により物点12でS $\beta$ の伸びを生じることになり、対物レンズの倍率をMとすると試料上ではMS $\beta$ の伸びを生じる。具体的な数値の典型的な一例を示すと、 $\theta = 30^\circ$ 、 $\Delta V = 0.3 eV$ 、 $V_0 = 1 kV$ 、として $V_R$ に対する $\beta$ は第3図に示すものとなる。この図から $\beta$ を大きく見積もって $5 \times 10^{-3}$ とし、 $S = 200 mm$ 、 $M = 1/50$ とすると、 $0.2 \mu m$ の伸びとなる。この値は、電子線2の所望の値(～nm)より非常に大きい。

そこで、本発明では第4図ならびに第1図に示すように、E×B形のフィルタ11を配置してこの色収差を自己消去できるようにした。すなわち、第4図から分かるように $\Delta V$ のエネルギー伸びを持つ電子線2があたかも物点12の一点から出たかのようになるようにフィルタ11を動作させる。このフィルタ11の偏向角 $\beta'$ は、

$$\beta' = S \beta / T \quad \dots \dots \dots (4)$$

とすればよい。

以上により、電子線2の径を増大させることな

したが、レンズの外側に配置された構成の光学系にたいしても実施することができる。なおこの場合、二次電子検出器は試料と対物レンズとの間にあってもよいし、第1図のように対物レンズの上側にあってもよいことはいうまでもない。要は、試料と二次電子検出器との間にE×B形のフィルタがあれば実現できる。

さらに、本発明は走査形電子顕微鏡に対して述べたが、これに限ることなく類似の電子線応用装置一般に適用できるし、さらにイオン線のような荷電粒子線応用装置一般に適用できることは言うまでもない。ただ、正の電荷を持っている荷電粒子線の場合には、減速電圧は正の値にする必要がある。

#### 【発明の効果】

本発明によれば、低加速領域でも荷電粒子線径を増大させることなく三次荷電粒子を検出器の方に偏向することが可能となるので、高分解能でかつ二次荷電粒子の高検出効率が得られる効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す荷電粒子光学系の断面図、第2図はE×B形フィルタの色収差に関する説明図、第3図はE×B形フィルタの色収差により生じる偏向角と試料に印加した加速電圧との関係曲線図、第4図はフィルタの色収差を自己打消しさせるための基本光学系の断面図、第5図はE×B形フィルタによる一次電子線と二次電子の軌道を示す説明図である。

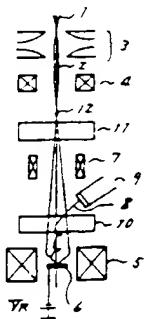
## 符号の説明

1: 電子線、2: 電子線、3: 加速レンズ、4: コンデンサレンズ、5: 対物レンズ、6: 試料、7: 側向器、8: 二次電子、9: 二次電子検出器、10, 11: E×B形フィルタ、12: 物点

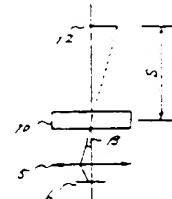
代理人 井理士 小川 謙男



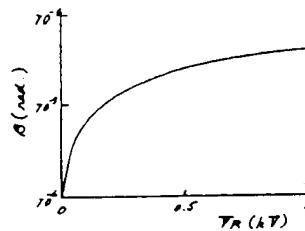
第1図



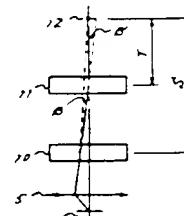
第2図



第3図



第4図



第5図

